

Pamięci półprzewodnikowe.

Cel pracy

Wstęp

Pamięci półprzewodnikowe o dostępie swobodnym

Czas dostępu do pamięci

Pamięć ROM

System pamięci ROM

PROM, EPROM, EEPROM

Pamięci Flash

Pamięć RAM

Pamięci DRAM i SRAM

Odświeżanie pamięci DRAM

Rodzaje dynamicznej pamięci DRAM

Tryb Burst

Mechanizmy Memory- Interleave i Pipelining

Zasada działania pamięci DRAM i SRAM

Budowa pamięci

Układy FPM-DRAM (Fast Page Mode RAM)

Układy EDO-DRAM Extended Data Output

Układy E-DRAM

Układy SDRAM (Synchroniczna DRAM)

Rodzaje modułów pamięci operacyjnej

Błędy parzystości

Kontrola parzystości

Pamięć SIMM z pseudobitem parzystości

Funkcje parzystości i ECC

Bit parzystości nie konieczny

Moduły ze złotymi stykami bardziej niezawodne

SIMM-y 9- i 3-chipowe

Jedno- i dwustronne moduły

72 pinowe SIMM-y typu single-sided i double-sided

Poprawne łączenie modułów pamięci

Czy moduły muszą mieć czas dostępu 60 lub 70 ns?

Czy można łączyć ze sobą moduły FPM i EDO?

Zakup pamięci RAM

Symbolika stosowana na układach pamięci

Skróty producentów są następujące

Pamięć VRAM

Pamięć WRAM

Pamięć SGRAM

Pamięć CMOS RAM

Pamięć cache

Rodzaje pamięci cache

Rodzaje zewnętrznych pamięci cache

Pamięć typu direct-mapped

Pamięć typu full associative

Inny podział pamięci cache

Cache a procesor Pentium

Optymalizacja pamięci

Słowniczek pamięci